

Asymmetric Dual N-Channel 30V (D-S) Power MOSFET

FEATURES

- Low $R_{DS(on)}$ to minimize conductive losses
- Low gate charge for fast power switching
- 100% UIS and R_g tested
- Compliant to RoHS directive 2011/65/EU and in accordance to WEEE 2002/96/EC
- Halogen-free according to IEC 61249-2-21

APPLICATIONS

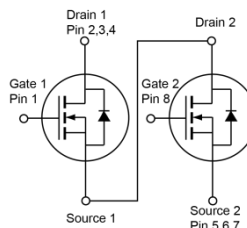
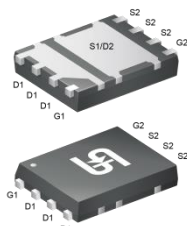
- IPC
- VGA
- NB VCORE

KEY PERFORMANCE PARAMETERS

PARAMETER	TYPE	VALUE	UNIT
V_{DS}	Q1	30	V
	Q2	30	
$R_{DS(on)}$ (max)	Q1	$V_{GS} = 10V$	11.7
		$V_{GS} = 4.5V$	14.9
	Q2	$V_{GS} = 10V$	3.6
		$V_{GS} = 4.5V$	5.5
Q_g	Q1	4.6	nC
	Q2	25	



PDFN56 Asymmetric Dual



Note: MSL 1 (Moisture Sensitivity Level) per J-STD-020

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A = 25^\circ C$ unless otherwise noted)

PARAMETER	SYMBOL	Q1	Q2	UNIT
Drain-Source Voltage	V_{DS}	30	30	V
Gate-Source Voltage	V_{GS}	± 20	± 20	V
Continuous Drain Current (Note 1)	I_D	$T_C = 25^\circ C$	38	A
		$T_A = 25^\circ C$	10	
Pulsed Drain Current	I_{DM}	152	428	A
Single Pulse Avalanche Current (Note 2)	I_{AS}	16	26	A
Single Pulse Avalanche Energy (Note 2)	E_{AS}	38	101	mJ
Total Power Dissipation	P_D	$T_C = 25^\circ C$	30	W
		$T_C = 125^\circ C$	6	
Total Power Dissipation	P_D	$T_A = 25^\circ C$	2.2	W
		$T_A = 125^\circ C$	0.4	
Operating Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	- 55 to +150		$^\circ C$

THERMAL PERFORMANCE

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT		UNIT
		Q1	Q2	
Thermal Resistance – Junction to Case	$R_{\theta JC}$	4.2	1.8	$^\circ C/W$
Thermal Resistance – Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	56	52	

Thermal Performance Note: $R_{\theta JA}$ is the sum of the junction-to-case and case-to-ambient thermal resistances. The case-thermal reference is defined at the solder mounting surface of the drain pins. $R_{\theta JA}$ is guaranteed by design while $R_{\theta CA}$ is determined by the user's board design.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)							
PARAMETER	CONDITIONS	SYMBOL	TYPE	MIN	TYP	MAX	UNIT
Static							
Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$	BV_{DSS}	Q1	30	--	--	V
	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$		Q2	30	--	--	
Gate Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 250\mu A$	$V_{GS(TH)}$	Q1	1.2	1.9	2.5	V
	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 250\mu A$		Q2	1.2	1.6	2.5	
Gate-Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$	I_{GSS}	Q1	--	--	± 100	nA
	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$		Q2	--	--	± 100	nA
Drain-Source Leakage Current	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 30V$	I_{DSS}	Q1	--	--	1	μA
	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 30V$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			--	--	100	
	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 30V$		Q2	--	--	1	
	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 30V$ $T_J = 125^\circ\text{C}$			--	--	100	
Drain-Source On-State Resistance <small>(Note 3)</small>	$V_{GS} = 10V, I_D = 10A$	$R_{DS(on)}$	Q1	--	8.8	11.7	m Ω
	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 9A$			--	12.8	14.9	
	$V_{GS} = 10V, I_D = 20A$		Q2	--	2.7	3.6	
	$V_{GS} = 4.5V, I_D = 16A$			--	3.7	5.5	
Forward Transconductance <small>(Note 3)</small>	$V_{DS} = 5V, I_D = 10A$	g_{fs}	Q1	--	27	--	S
	$V_{DS} = 5V, I_D = 20A$		Q2	--	47	--	
Dynamic <small>(Note 4)</small>							
Total Gate Charge	Q1 $V_{DS} = 15V, I_D = 10A$ Q2 $V_{DS} = 15V, I_D = 20A$	$Q_{g(VGS=10V)}$	Q1	--	9.3	--	nC
			Q2	--	49	--	
Total Gate Charge	Q1 $V_{DS} = 15V, I_D = 9A$ Q2 $V_{DS} = 15V, I_D = 16A$	$Q_{g(VGS=4.5V)}$	Q1	--	4.6	--	nC
			Q2	--	25	--	
Gate-Source Charge	$V_{DS} = 15V, I_D = 9A$	Q_{gs}	Q1	--	2.1	--	nC
			Q2	--	7.3	--	
Gate-Drain Charge	$V_{DS} = 15V, I_D = 16A$	Q_{gd}	Q1	--	1.8	--	nC
			Q2	--	12	--	
Input Capacitance	Q1 $V_{GS} = 0V, V_{DS} = 15V$	C_{iss}	Q1	--	555	--	pF
			Q2	--	2550	--	
Output Capacitance	f = 1.0MHz Q2	C_{oss}	Q1	--	142	--	pF
			Q2	--	388	--	
Reverse Transfer Capacitance	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 15V$ f = 1.0MHz	C_{rss}	Q1	--	26	--	pF
			Q2	--	276	--	
Gate Resistance	f = 1.0MHz	R_g	Q1	0.5	1.6	3.2	Ω
			Q2	0.5	1.5	3	

ELECTRICAL SPECIFICATIONS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)							
PARAMETER	CONDITIONS	SYMBOL	TYPE	MIN	TYP	MAX	UNIT
Switching (Note 4)							
Turn-On Delay Time	Q1 $V_{GS} = 10\text{V}, V_{DS} = 15\text{V},$ $I_D = 10\text{A}, R_G = 2\Omega$ Q2 $V_{GS} = 10\text{V}, V_{DS} = 15\text{V},$ $I_D = 20\text{A}, R_G = 2\Omega$	$t_{d(on)}$	Q1	--	4.8	--	ns
			Q2	--	11	--	
Turn-On Rise Time		t_r	Q1	--	65	--	
			Q2	--	79	--	
Turn-Off Delay Time		$t_{d(off)}$	Q1	--	8.2	--	
			Q2	--	32	--	
Turn-Off Fall Time		t_f	Q1	--	14	--	
			Q2	--	49	--	
Source-Drain Diode							
Forward Voltage (Note 3)	$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = 10\text{A}$	V_{SD}	Q1	--	--	1.2	V
	$V_{GS} = 0\text{V}, I_S = 20\text{A}$		Q2	--	--	1	
Reverse Recovery Time	Q1 $I_S = 10\text{A}, dI/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	t_{rr}	Q1	--	33	--	ns
			Q2	--	14	--	
Reverse Recovery Charge	Q2 $I_S = 20\text{A}, dI/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$	Q_{rr}	Q1	--	19	--	nC
			Q2	--	8	--	

Notes:

- Silicon limited current only.
- Q1 : $L = 0.3\text{mH}, V_{GS} = 10\text{V}, V_{DD} = 30\text{V}, R_G = 25\Omega, I_{AS} = 16\text{A}$, Starting $T_J = 25^\circ\text{C}$
 Q2 : $L = 0.3\text{mH}, V_{GS} = 10\text{V}, V_{DD} = 30\text{V}, R_G = 25\Omega, I_{AS} = 26\text{A}$, Starting $T_J = 25^\circ\text{C}$
- Pulse test: Pulse Width $\leq 300\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$.
- Switching time is essentially independent of operating temperature.

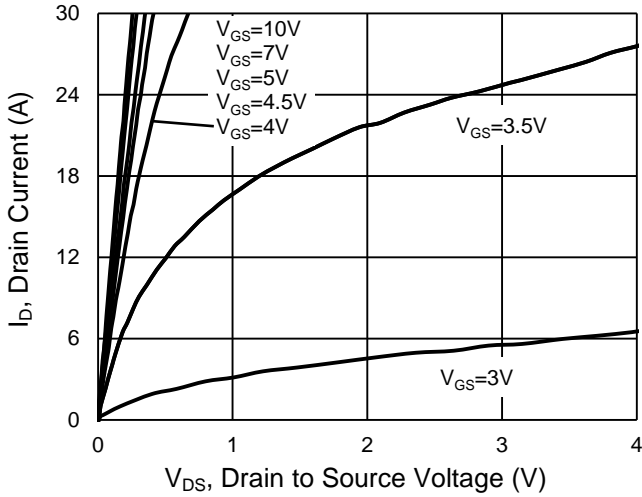
ORDERING INFORMATION

PART NO.	PACKAGE	PACKING
TSM5055DCR RLG	PDFN56 Asymmetric Dual	2,500pcs / 13" Reel

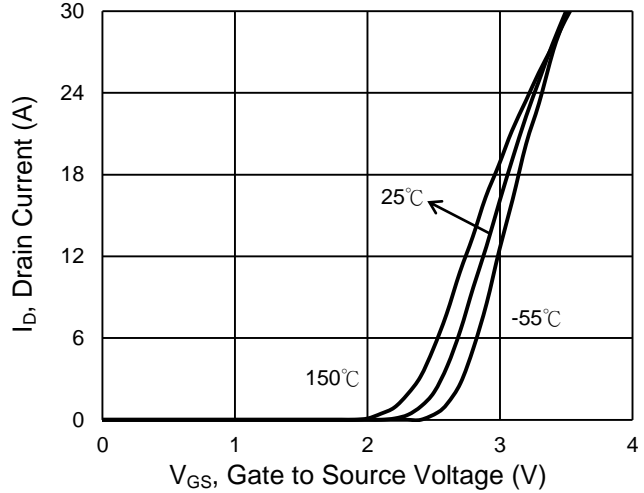
CHARACTERISTICS CURVES (Q1)

($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

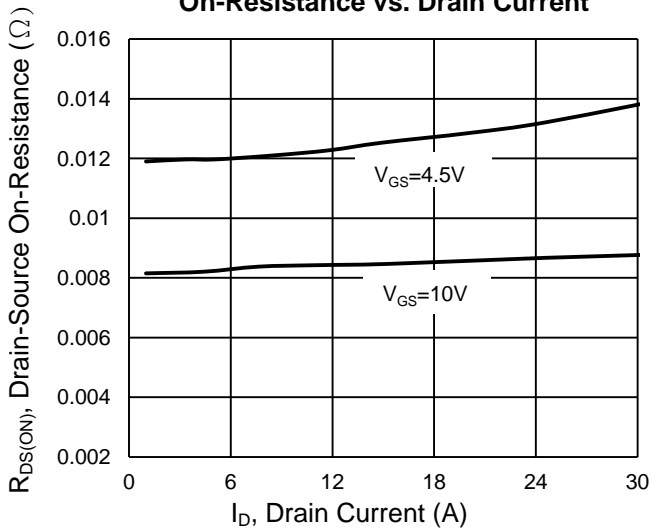
Output Characteristics



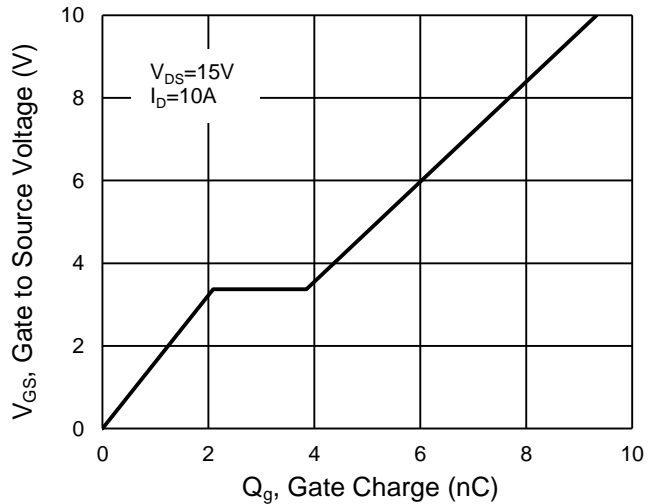
Transfer Characteristics



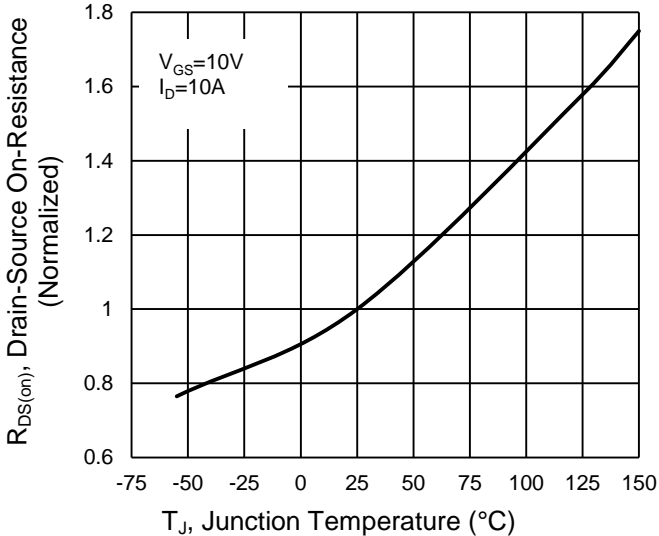
On-Resistance vs. Drain Current



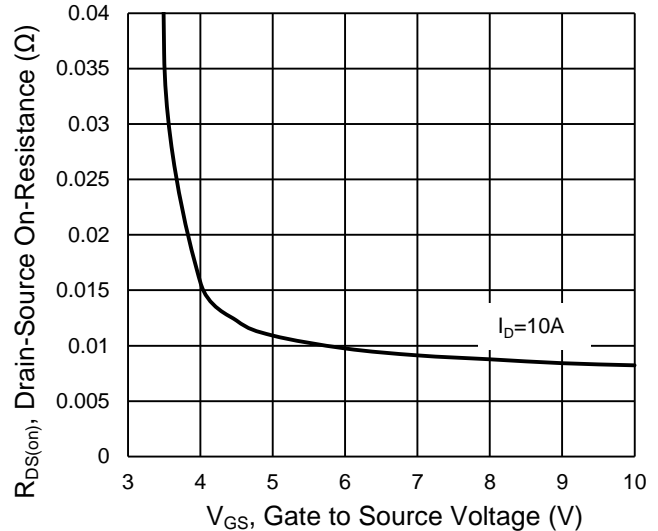
Gate-Source Voltage vs. Gate Charge



On-Resistance vs. Junction Temperature

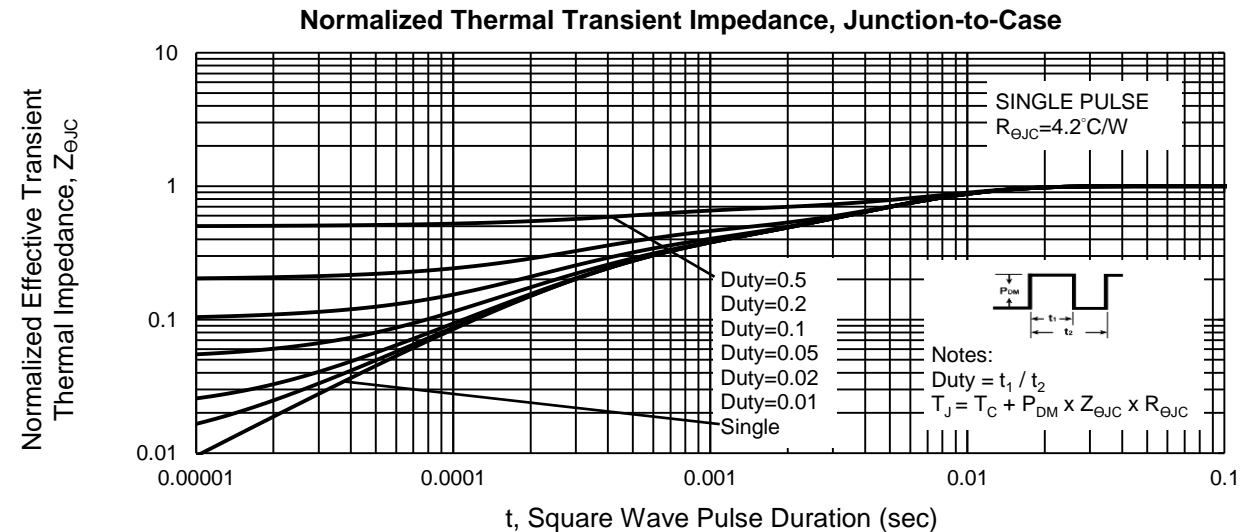
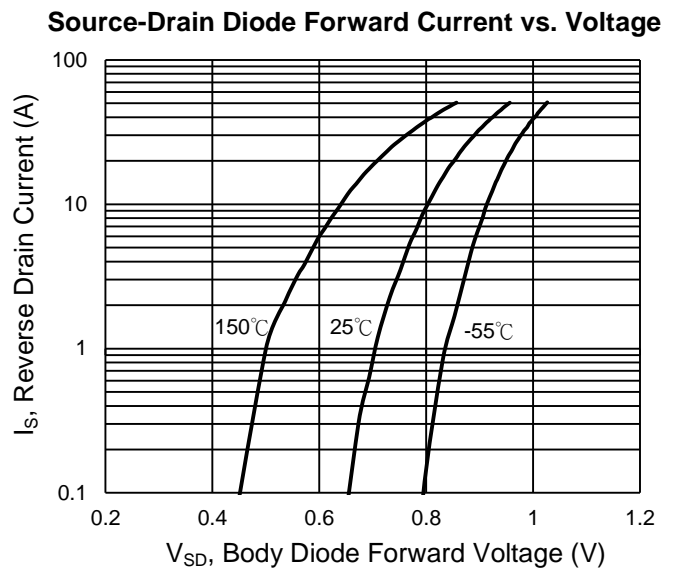
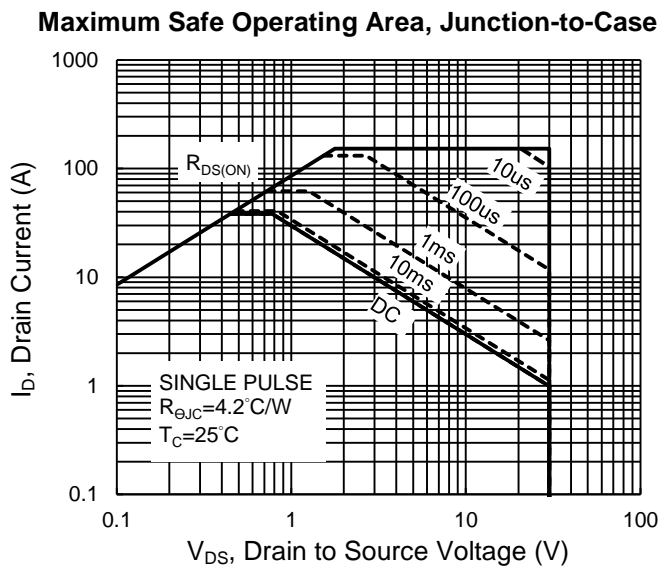
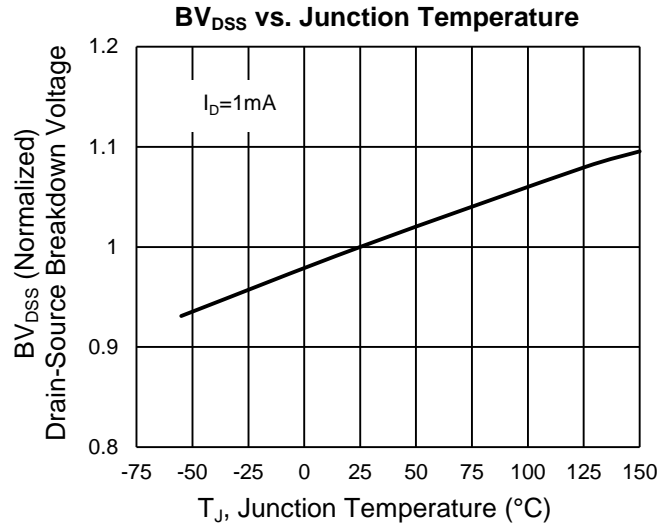
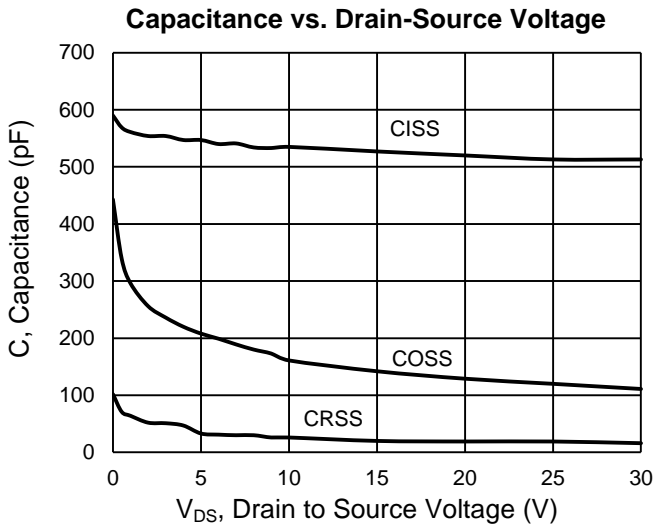


On-Resistance vs. Gate-Source Voltage



CHARACTERISTICS CURVES (Q1)

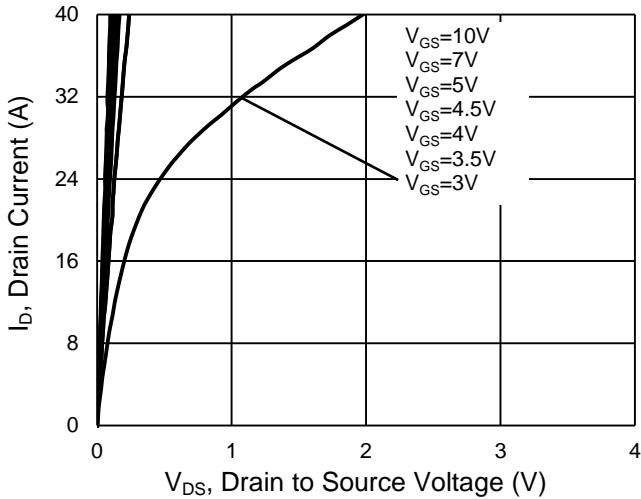
($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)



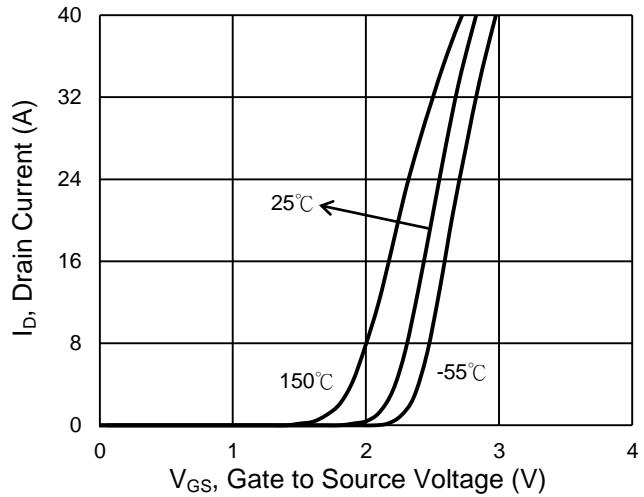
CHARACTERISTICS CURVES (Q2)

($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

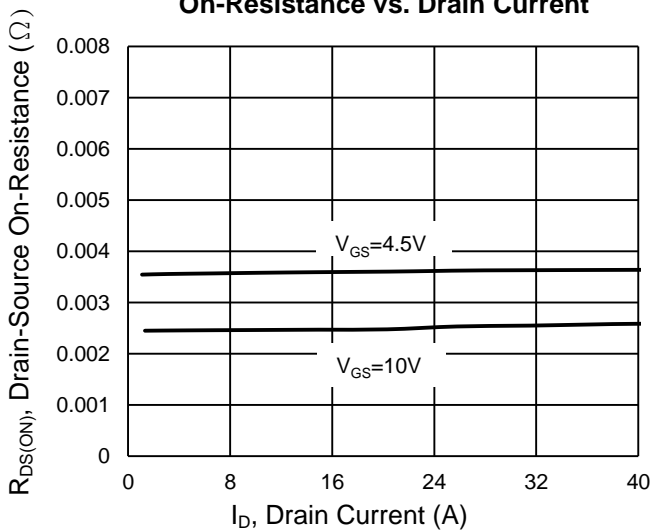
Output Characteristics



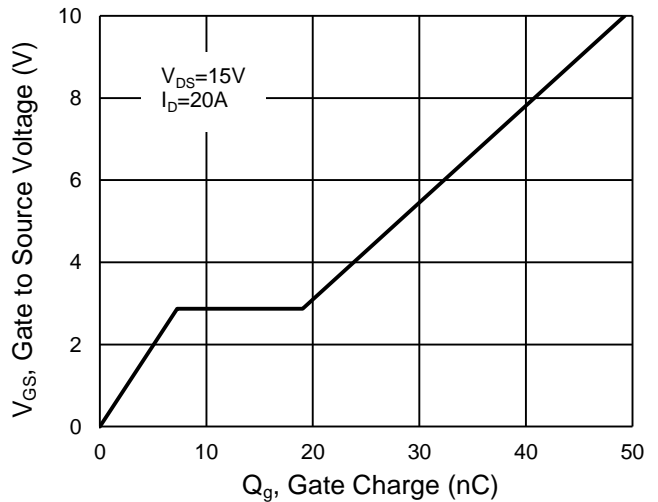
Transfer Characteristics



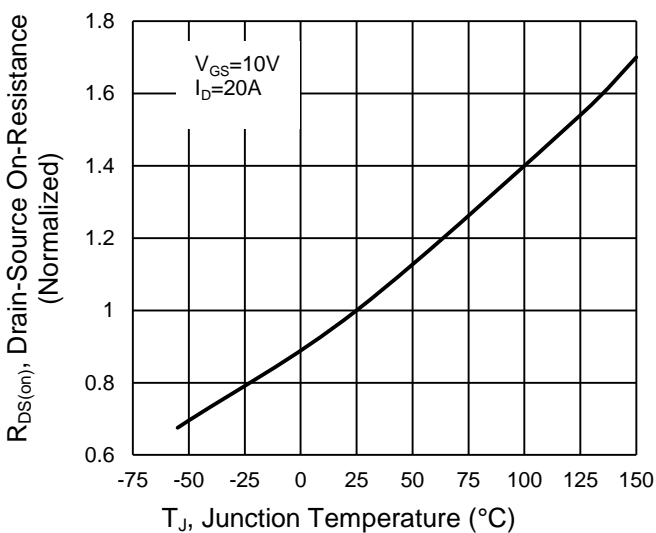
On-Resistance vs. Drain Current



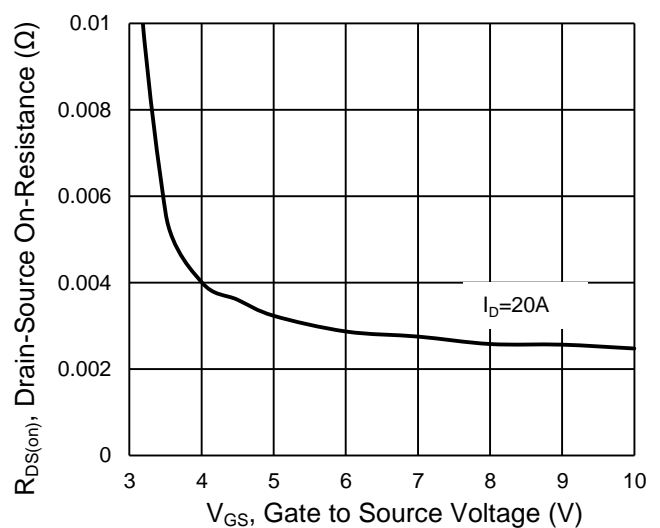
Gate-Source Voltage vs. Gate Charge



On-Resistance vs. Junction Temperature

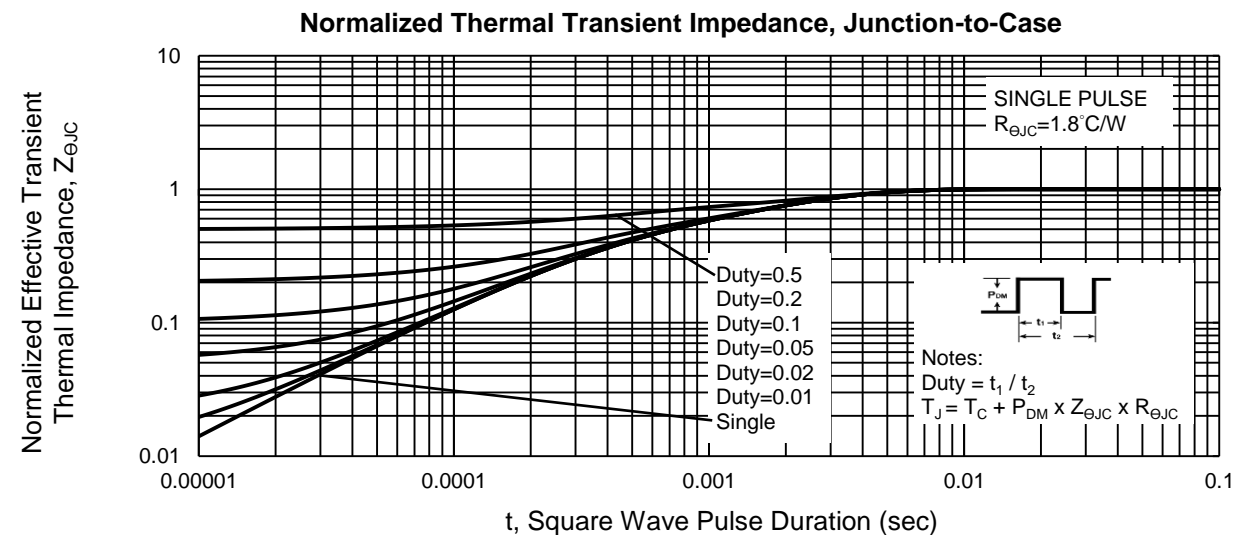
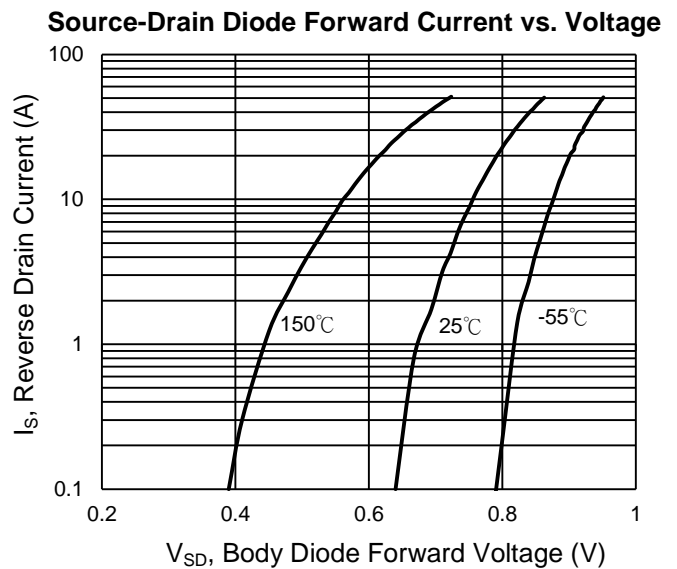
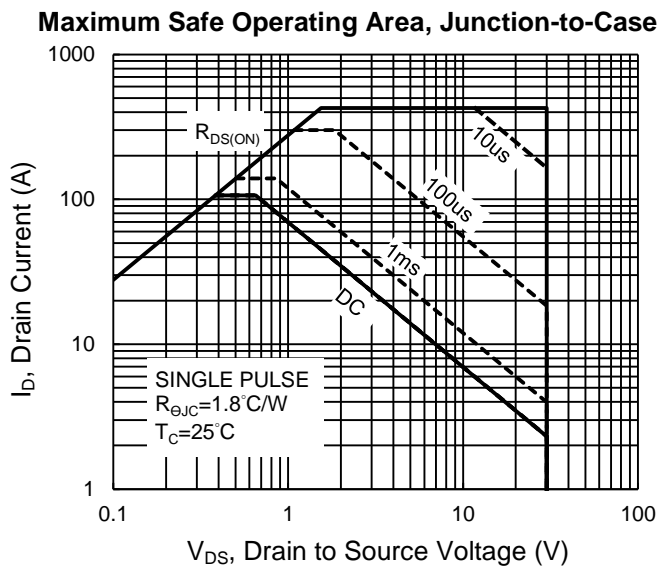
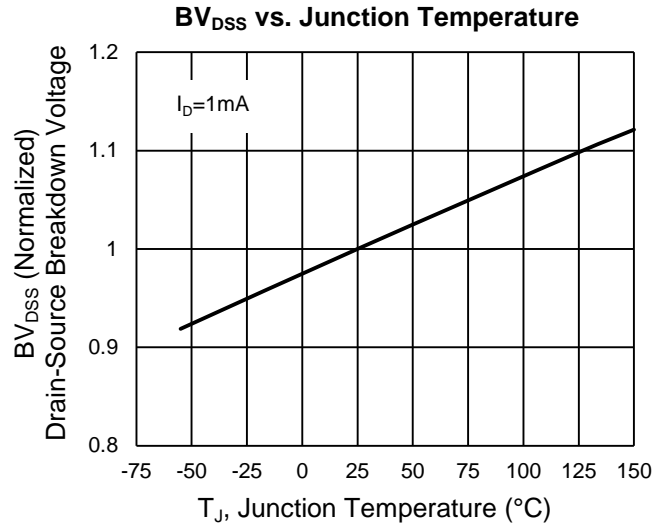
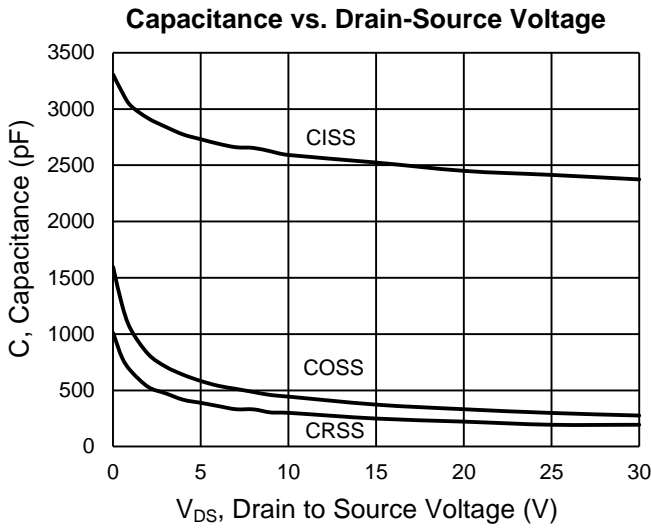


On-Resistance vs. Gate-Source Voltage



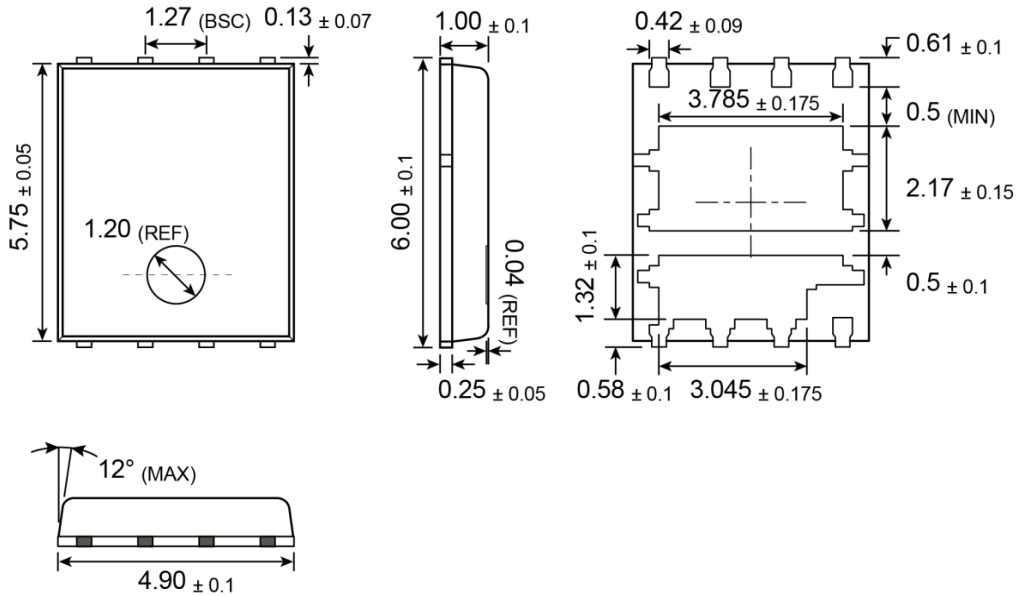
CHARACTERISTICS CURVES (Q2)

($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

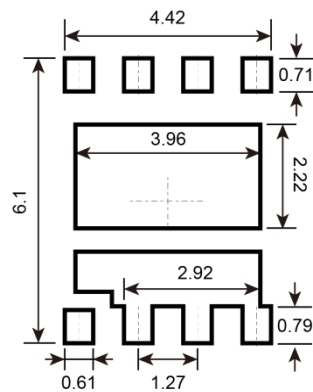


PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS (Unit: Millimeters)

PDFN56 Asymmetric Dual



SUGGESTED PAD LAYOUT (Unit: Millimeters)



MARKING DIAGRAM



- G** = Halogen Free
- Y** = Year Code
- WW** = Week Code (01~52)
- F** = Factory Code

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А